微細計測技術

Technologies for Sub-micrometer Measuring Apparatus

最新の電子部品は微細化高精度化が顕著であるためサブミクロン以下の精 度で計測する評価装置が重要になってきている。当社では光学顕微鏡をベー スとした光学技術に高精度機械設計技術と画像処理技術を組み合わせ,様々 な検査装置を開発している。GMR素子並び測定では,長さ50mmに沿って並 んだ素子の素子並びを3 =30nmの精度で測定する技術を開発した。GMR素 子異物検出では,段差1.8µmのパターン上に付着した異物を0.3µmの検出限 度で検出する技術を開発した。

With the increasing accuracy of electronic components, the development of evaluation apparatus with sub-micrometer measuring performance is very important. We have developed various types of testing apparatus that combine three key technologies: optical technology based on optical microscopy, high-accuracy machine-design technology, and image-processing technology. For a Giant-Magneto-Resistive cell-alignment measuring system, we developed technology for measuring cell alignment that has three-sigma accuracy of 30 nm along a stroke of 50 mm. For a GMR foreign-particle detection system, we developed technology for detecting foreign particles as small as 0.3 micrometers on a layer of 1.8 micrometers thick.

● 緒 言

GMRヘッド¹⁾に代表される成膜プロセスを有する電子 部品の製造で良好な成膜を行うためには,スパッタ装置 に代表される製造設備のほかに,微細なパターンの寸法 や形成位置を計測する装置や,異物を検出したりパター ンの形状を検査する装置も重要である。

これら計測装置は、ミクロンオーダのものから光学限 界に近いサブミクロンオーダ、ナノオーダの精度が要求 される。高精度な評価にはSEM、AFMなどの高分解能 計測装置が利用されるが、前処理に時間がかかる、使い 勝手が悪いなどの問題があり、インラインでは光学技術 を応用した評価装置が多用されている。

光学式の評価装置を開発するためには,顕微鏡をベースとする光学技術のほかに,光の波長以下の分解能で計 測値を求める画像処理技術や高精度のメカニズム設計技 術が必須である。さらに,これらの技術をまとめる技術 も必要である。

当社ではこれらの要素技術を組み合わせて,様々な検 査装置,具体的には,寸法や位置を計る計測装置や異物 やパターン不良などを検査する外観検査装置を開発して いる。

本稿では,寸法を計測する装置の開発例としてGMR 素子並び測定装置を,また,外観を検査する装置の開発 例としてGMR異物検査装置を報告する。

④ GMR素子並び測定装置

2.1 並び測定の目的と目標仕様

GMR素子と浮上面までの寸法を高精度に決めるため, GMR素子とラダーセンサ(以下,RLGという)を一直線 上に並べて,RLGの抵抗値が一定になるまでラップ加工 を行う方法を用いている。この加工方法では,成膜時に 素子の並びとミスマッチ量を高精度に規制しなければな らない。そこで,ウェーハの段階で素子の並びを計測で きる装置を開発し,測定結果を製造プロセスにフィード バックすることにした。

図1は素子並びとミスマッチを説明する図である。素 子並びはGMR素子,または,RLGの真直度のことであり, ミスマッチは,GMR素子とRLGの相対的な位置ずれのこ とである。



図 1 GMR素子の 並び測定

Fig. 1 Measurement of alignment and mismatch for GMR cell

- 日立金属株式会社 生産システム研究所
- * Production System Laboratory, Hitachi Metals, Ltd.

Takaharu Yoshimura Shigeyuki Nishi Motoyuki Itoh

吉村剛治*

西 重幸*

伊藤元诵*

目標仕様を**表1**に示す。

表1 目標仕様

Table 1 Specifications of GMR alignment measuring system

項目	仕様
測定精度	3 < 100 nm/56.3 mm
測定項目	素子並び(GMR素子,RLG)
	ミスマッチ(GMR素子)
タクト	5s/素子

2.2 技術課題と対策

技術課題と対策を表2に示す。

表2 技術課題と対策

Table 2 Technical problems with GMR alignment measuring system and solutions

技術課題	対 策
(1)高精度な素子送り	エアースライドテーブル
(2)高解像度画像の生成	コンフォーカル顕微鏡
	ピエゾ駆動対物レンズ
	ウェーハのチルト機構
(3)温度ドリフト	アンバー材と石定盤
(4) 耐振動	懸垂形大型防振台
(5)エッジ検出処理	パターンマッチング処理

(1)高精度素子送り

画像処理の視野の大きさは35×26µmであり,56.3mm の長さに一列に並んだすべての素子を一度に計測するこ とができない。そこで,エアスライドテーブルを用いて ウェーハを高精度で送ることにした。駆動にはエアスラ イドテーブルと平行に駆動用のテーブルを固定し,送り 方向には高速応答,高精度位置決めができ,横方向には 影響を与えないユニバーサルジョイントを開発した 200mmのストロークで真直度60nm,50mmのストローク で真直度10nm,再現性3 =8nmの素子送りを実現した。 (2)高解像度画像の生成

顕微鏡は解像度の良いコンフォーカル式顕微鏡を用 い,焦点合わせは対物レンズをピエゾアクチュエータで 上下に移動させる方法を用いた。焦点合わせのために対 物レンズを上下動させても,結像位置は横方向に 0.1nm/100μm程度しか移動しないので,焦点合わせに よる測定誤差を無視できる。

(3)温度ドリフト

顕微鏡を低背構造にする,鏡体部を石材で高剛性にする,発熱体である光源と鏡筒を支持する部分にアンバー 材を使用するなどの対策を行った。

温度ドリフトは1µm/Kであった。

(4) 耐振動

振動の伝達を抑える十分な重さを持つ石定盤と,6箇 所の空気ばねを有する懸垂型大型防振台を用いた。

図2に並び測定装置の外観を示す。

(5) エッジ検出処理

原画像での画素サイズは55nmであるため画素サイズ の半分以下でエッジを検出するアルゴリズムを開発し た。図3にアリゴリズムを示す。



図2 並び測定装置の外観

Fig. 2 External view of GMR alignment measuring system



図 3 エッジ検出アルゴリズム

Fig. 3 Algorithm for edge detection

原画像に対して略位置サーチ画像を用いてパターンマ ッチング処理を行い目標点を抽出する。そして,目標点 を中心とするエッジ位置検出領域を5倍ほど拡大して画 素サイズが11nmの画像を作成する。この画像に対して エッジサーチ画像を用いてパターンマッチング処理を行 い,エッジを求める。

エッジサーチ画像では目的のエッジをその投影分布か らあらかじめ求めており,パターンマッチング処理で合 致する部位を求めることでエッジが検出できる。

エッジ検出の再現性は3 =10nmであった。

2.3 試運転結果

図4(a)は、約50mmの長さに沿って並んだ11個の RLGを測定した一例である。10回ほど繰り返して素子並 びを求めた結果であるが,再現性は3 =14~32nmであ った。同図の100nm程度の不連続は露光ショットの切れ 目である。この結果をウェーハの露光プロセスにフィー ドバックすることで不連続が生じないようにした。

同図(b)は、GMR素子のミスマッチ量である。再現 性は3 =8~13nmであった。



図4 RLG並び測定値とGMRミスマッチの再現性 Fig. 4 Repeatability of measured value

6 GMR素子異物検査装置

3.1 装置開発の目的と目標仕様

GMR素子と外部端子を電気的に接続する電極領域で異 物の検査を行う。電極領域には信号読み出しのために電 圧が印加されるが,異物があると絶縁層が極端に薄かっ たり破壊されたりしているので,印加電圧によて素子が 絶縁破壊を起こす可能性が高くなり,絶縁不良の主要因 になっている。異物の発生原因はウェーハの製造プロセ スでのレジスト残り、洗浄での再付着など多種多様であ る。

表3に異物検査装置の目標仕様を示す。

表3 目標仕様

Table 3 Specifications of GMR foreign-particles detection system

項目	仕様
測定部位	電極領域
検索のタイニング	ボトムシールド形成後
快旦のタイミング	電極領域形成後
検出限度	0.5µm
タクト	1s/素子

3.2 技術課題と対策

技術課題と対策を表4に示す。

表4 技術課題と対策

Table 4 Technical problems with GMR foreign-particles detection system and solutions

技術課題	対 策
	暗視野照明
(1) 微小異物の検出	異物強調フィルタ処理
	高解像度カメラ
(2)段差部ノイズの除去	マスク処理による段差部除去
(3)雰囲気中粉塵の付着	防塵カバー&クリーンベンチ
(4)マップ表示	オフライン処理

(1) 微小異物の検出

図5に明視野照明と暗視野照明で撮像した画像を示 す。図中の 印が異物であるが,明視野では黒点として, 反対に暗視野では白点として観察される。明視野では背 景によって明るさが異なりノイズになるが,暗視野では それがない。そこで,暗視野照明で異物を検出すること にした。

また,対象とする異物の大きさが非常に小さいので, 1.300×1.000画素の高解像度カメラで画像取り込みを行 い,さらに,微分フィルタ処理で異物を強調する処理を 加えた。



(a)明視野照明

暗視野照明と段差部の輪郭

Fia. 5 Comparison of GMR cell image between 2 types lighting

(2) 段差部ノイズの除去

図 5

暗視野照明は表面の微小凹凸を強調する照明方法であ るが,GMR素子には厚さが1.8µmのパターン層があり, その段差部でも凹凸として強調され,白い帯として画像 に現れて異物検出のノイズになる。

電極領域を抽出して、そこの画像に着目して異物を検 出するアルゴリズムを開発した。

図6に異物検出アルゴリズムを示す。

取り込んだ画像に対して微分フィルタ処理を行い異物 を強調すると共に段差部のノイズを除去した画像を作成 する。次に,電極領域の位置をパターンマッチングで求 めて、この位置で電極のパターンをマスクパターンとす る画像と論理積処理を行って電極領域の異物だけが残っ た画像を作成する。

2値化処理を行って白画素数をカウントして異物を検 出する。



図6 異物検出アルゴリズム

- Fig. 6 Algorithm for foreign-particles detection
- (3) 雰囲気中粉塵の付着

異物検査している間に雰囲気中に浮遊の粉塵がウェー ハに再付着するとこれも異物となるので,カバーをつけ ると共に,クリーンベンチからのエアーを,ウェーハ上 面をウェーハと平行の方向に流し,異物がウェーハに付 着しないようにした。

(4) マップ表示

検査結果をビジュアル化するため,異物をマップ表示 するソフトを開発した。

図7に異物検査装置の外観を示す。



図7 異物検査装置の外観

Fig. 7 External view of foreign-particle detection system

3.3 試運転結果

図8に検査装置で検出した異物の寸法値とSEMで計測した異物の寸法値の比較結果を示す。

SEMに比べて検査装置の方が大きめの値になっていた。なお,SEMで計測した異物の寸法値から検査装置の検出限度を求めると,0.3µmであった。

また,異物のうち,膨れ状の欠陥では比較的相関がと れているが,平板状ではばらつきが大きくなった。これ は突起のない異物では暗視野照明での反射光ができない ためと考えられる。一方,しみ,スクラッチでも突起が ある部分では異物として検出される。



図 8 SEMとの比較

Fig. 8 Comparison of evaluation size between development system and SEM

図9にウェーハでの異物マップの例を示す。ウェーハ での素子数は20868個で,異物の数を擬似カラー表示で 表している。この例では異物の個数は5~10個の素子が 大半を占めていることや,周辺よりも中央部の方が異物 が多いことなどがわかる。



図 9 ウェーハ内異物マップ Fig. 9 Particle map of GMR wafer

4 結 言

光学技術を用いてインラインで使用できる微細計測技 術を開発した。

GMR素子並び測定装置では、コンフォーカル顕微鏡 に、エアースライドテープルによる高精度素子送りなど の高精度のメカニズム設計技術とエッジ検出画像処理技 術を加えて、約50mmの長さにわたって並んだ素子の並 びを3 =30nmの精度で測定する技術を開発した。

GMR異物検査装置では,暗視野照明に段差部ノイズ 除去画像処理を加えて,0.3µmの検出限度で異物を検出 する技術を開発した。

参考文献

1)小林,他:日立金属技報,13(1997),37